

Traduction



DMT

(1) **Certificat d'examen CE de type**

(2) **— Directive 94/9/CE —**
Appareils et systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

(3) **BVS 03 ATEX E 410 U**

(4) **Appareil :** **Platine processeur de Type 700**

(5) **Fabricant :** **Micro Motion**

(6) **Adresse :** **NL-3900 AJ VEENENDAAL, Pays-Bas**

(7) Le type de cet appareil, ainsi que ses différentes variantes autorisées, sont indiqués dans l'Annexe au présent certificat d'examen.

(8) L'organisme de certification de Deutsche Montan Technologie GmbH, organisme notifié sous le n° 0158 conformément à l'article 9 de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, atteste que l'appareil susmentionné satisfait aux exigences fondamentales de sécurité et de santé en matière de conception et de construction d'appareils et de systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles conformément à l'Annexe II de la directive.
Les résultats des essais ont été consignés dans le Procès-verbal d'essai BVS PP 03.2266 EG.

(9) Les exigences fondamentales de sécurité et de santé sont remplies du fait de la conformité à :

EN 50014:1997 + A1 — A2 Dispositions générales
EN 50020:2002 Sécurité intrinsèque 'i'

(10) Le signe "U" qui se trouve derrière le numéro du certificat indique que le présent Certificat ne doit pas être confondu avec un certificat prévu pour un appareil ou un système de protection. Le présent Certificat ne doit servir que de base à la certification d'un appareil ou d'un système de protection.

(11) Le présent Certificat d'examen CE de type ne porte que sur la conception et les essais du type de l'appareil décrit conformément à la directive 94/9/CE.
La fabrication et la mise sur le marché de l'appareil sont soumises à d'autres exigences stipulées par la directive, lesquelles ne sont pas couvertes par le présent Certificat.

(12) L'identification de cet appareil doit comprendre les indications suivantes :



II 2G EEx ib IIB/IIC T5

Deutsche Montan Technologie GmbH

Bochum, le 11 décembre 2003

Signature
Organisme de certification

Signature
Responsable du service spécialisé

Page 1 de 3 de BVS 03 ATEX E 410 U

Ce certificat ne peut être remanié que sous sa forme initiale.

Dinnendahlstrasse 9 — D-44809 Bochum — Tél. : +49 201 172 39 47, Fax : +49 201 172 39 48
(jusqu'au 31.05.2003 : Deutsche Montan Technologie GmbH — Am Technologiepark 1 — D-45307 Essen)

(13)

Annexe au

(14)

Certificat d'examen CE de type

BVS 03 ATEX E 410 U

(15)

15.1 Objet et type

Platine processeur de Type 700

15.2 Description

La Platine processeur sert au raccordement des capteurs au transmetteur.

Les composants électriques sont entièrement scellés dans un boîtier en plastique. Sur ce boîtier sont placées des bornes pour le raccordement des circuits électriques à partir du et vers le transmetteur, le raccordement du capteur se faisant au moyen d'un connecteur à 9 fiches situé sur le côté inférieur.

15.3 Paramètres

15.3.1 Circuits d'alimentation (borniers 1 - 4)

Tension	Ui	DC	17,3	V
Intensité	Ii		484	mA
Puissance	Pi		2,1	W
Capacité interne effective	Ci		2200	pF
Inductance interne effective	Li		30	μH

15.3.2 Circuits de sortie (du capteur)

15.3.2.1 Circuit d'excitation (ergots 7 - 8)

Tension	Uo	DC	10,5	V
Intensité	Io		2,45	A
Puissance	Po		2,54	W
Résistance interne	Ri		4,32	Ω

Pour le groupe IIC

Capacité externe max.	Co		2,41	μF
Inductance externe max.	Lo		5,9	μH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro		5,5	μH/Ω

Pour le groupe IIB

Capacité externe max.	Co		16,8	μF
Inductance externe max.	Lo		24	μH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro		22	μH/Ω

15.3.2.2 Circuit de détection (ergots 3 - 6)

Tension	Uo	DC	17,3	V
Intensité	Io		6,9	mA
Puissance	Po		30	mW

Pour le groupe IIC			
Capacité externe max.	Co	353	nF
Inductance externe max.	Lo	742	mH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro	1,19	$\mu\text{H}/\Omega$

Pour le groupe IIB			
Capacité externe max.	Co	2,06	μF
Inductance externe max.	Lo	2,97	H
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro	4,75	$\mu\text{H}/\Omega$

15.3.2.3	Circuit de la sonde de température (ergot 1, 2 et 9)		
	Tension	Uo	DC 17,3 V
	Intensité	Io	26 mA
	Puissance	Po	112 mW

Pour le groupe IIC			
Capacité externe max.	Co	353	nF
Inductance externe max.	Lo	52,6	mH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro	0,32	$\mu\text{H}/\Omega$

Pour le groupe IIB			
Capacité externe max.	Co	2,06	μF
Inductance externe max.	Lo	210	mH
Rapport max. inductance ext./résistance ext.	Lo/Ro	1,26	$\mu\text{H}/\Omega$

15.3.3	Plage de température ambiante	Ta	- 40 °C à + 60 °C
--------	-------------------------------	----	-------------------

(16) Procès-verbal d'essai
BVS PP 03.2266 EG, en date du 11.12.2003

- (17) Consignes d'utilisation
- 17.1 La Platine processeur doit être encastrée dans un boîtier qui assure au moins une protection de niveau IP 20, conformément à la norme EN 60529.
- 17.2 L'encastrement de la Platine processeur dans un boîtier doit être réalisé de telle sorte que l'entrefer entre les éléments de raccordement et les parties métalliques mises à la terre soit au minimum de 3 mm.